

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0406U001590

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-04-2006

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Єгоров Сергій Геннадійович

2. Egorov Sergey Gennadjevich

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 05.16.03

Назва наукової спеціальності:

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 05-04-2006

Спеціальність за освітою: 7.090402

Місце роботи здобувача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових сплавів"

Код за ЄДРПОУ: 31549003

Місцезнаходження: 69015, м. Запоріжжя, вул. Минська, 7

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 17.100.02

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Запорізька державна інженерна академія

Код за ЄДРПОУ: 05402565

Місцезнаходження: 69006, Запоріжжя, пр. Соборний, 226

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 53.37.13

Тема дисертації:

1. Вплив характеристик розплаву на умови кристалізації та властивості вирощуваних кристалів кремнію
2. The influences of melt characteristic on silicon crystallization conditions and property of grown single crystals

Реферат:

1. Уперше встановлений зв'язок між швидкістю конвекційних потоків у зоні розплаву і товщиною дифузійного шару на фронті кристалізації монокристалу, ефективним коефіцієнтом розподілу домішок і параметрами вирощених монокристалів кремнію методом індукційної безтигельної зонної плавки. На основі проведених досліджень розроблена математична модель для опису конвекційних потоків і розподілу домішок у зоні розплаву. Пропонується технологічний прийом усунення негативного впливу конвекційних потоків з метою збільшення питомого електричного опору монокристалів кремнію.
2. The connection between speed of convectional streams in a melt zone and thickness of a diffusion layer at the front crystallizations of a single crystal, the effective coefficient of impurities distribution and parameters of the grown silicon single crystals by a induction floating-zone melting method for the first time is determined. On a base of the carried out investigations the mathematical model for exposition of convectional streams and the allocation of impurities in a melt zone is designed. The reception of removal of negative influence of convectional streams is offered with the purpose of magnification of the specific electrical resistance of silicon single crystals.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Червоний Іван Федорович

2. Chervony Ivan Fedorovich

Кваліфікація: д.т.н., 05.16.03

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Куцова Валентина Зінов'євна

2. Куцова Валентина Зінов'євна

Кваліфікація: д.т.н., 05.16.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

